

BIOMHXANIKH HAEKTPONIKH

Α. Αντωνόπουλος

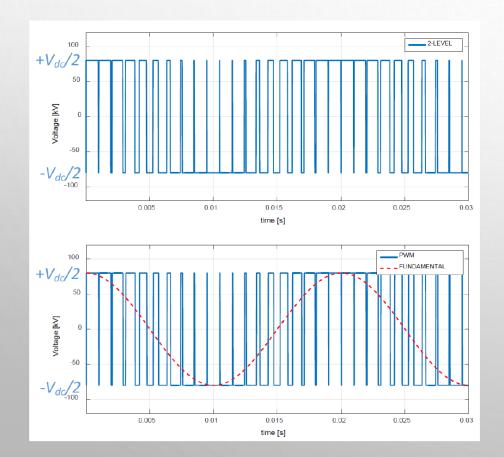
Διάλεξη 6

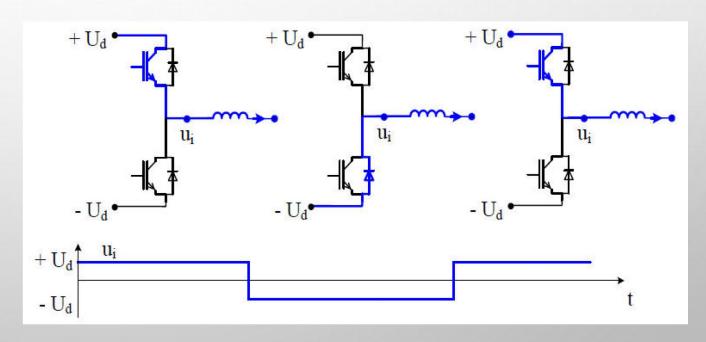
12/12/2022



Περιεχόμενο διάλεξης

- Τεχνικές διαμόρφωσης μονοφασικών και τριφασικών αντιστροφέων ισχύος
- Αρμονικό περιεχόμενο



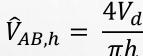


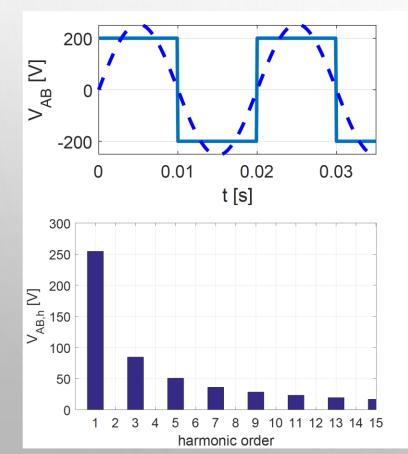


Μονοφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας – Ανάλυση τάσης εξόδου

• Πλήρους τετραγωνικού παλμού

$$\hat{V}_{AB,h} = \frac{4V_d}{\pi h}$$





• Με επικάλυψη αγωγής – έλεγχος πλάτους

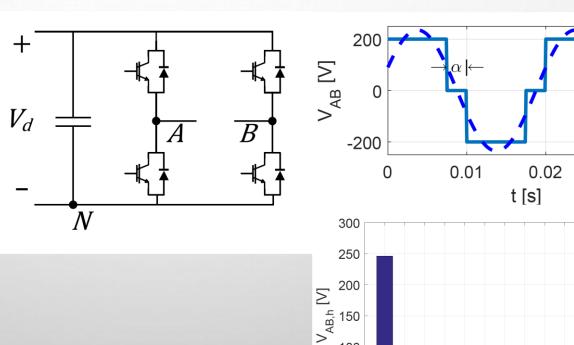
$$\hat{V}_{AB,h} = \frac{4V_d}{\pi h} \sin(h\beta)$$
, όπου $\beta = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$

9

harmonic order

0.03

10 11 12 13 14 15



100

50



Όρια αρμονικής παραμόρφωσης – Πρότυπο ΙΕΕΕ 519-2014

Table 1—Voltage distortion limits

| Bus voltage V at PCC | Individual harmonic (%) | Total harmonic distortion THD (%) |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| $V \le 1.0 \text{ kV}$ | 5.0 | 8.0 |
| $1 \text{ kV} \le V \le 69 \text{ kV}$ | 3.0 | 5.0 |
| 69 kV < V ≤ 161 kV | 1.5 | 2.5 |
| 161 kV < V | 1.0 | 1.5ª |

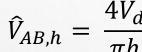
THD_v% =
$$\frac{\sqrt{\sum_{n=2,3,4,...}^{\infty} V_n^2}}{V_1} \cdot 100 = \frac{\sqrt{V_{\text{rms}}^2 - V_{1,\text{rms}}^2}}{V_{1,\text{rms}}} \cdot 100$$

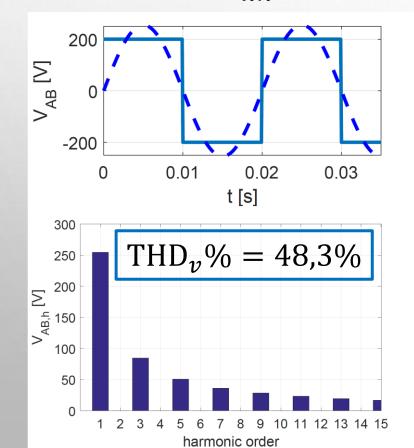


Μονοφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας – Παραμόρφωση τάσης εξόδου

• Πλήρους τετραγωνικού παλμού

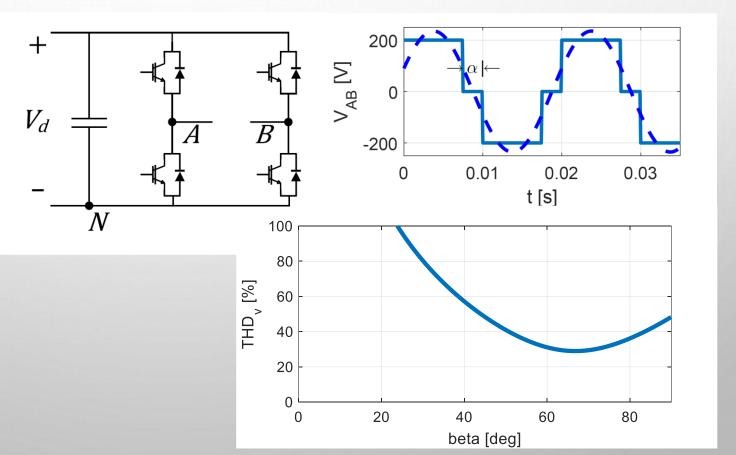
$$\hat{V}_{AB,h} = \frac{4V_d}{\pi h}$$





• Με επικάλυψη αγωγής – έλεγχος πλάτους

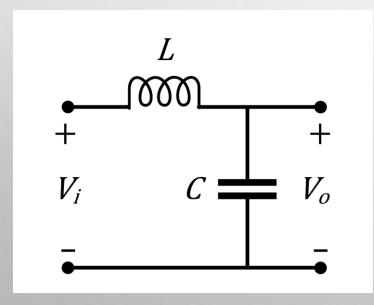
$$\hat{V}_{AB,h} = \frac{4V_d}{\pi h} \sin(h\beta)$$
, όπου $\beta = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$





Χρήση παθητικών φίλτρων σε διατάξεις ισχύος

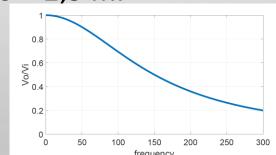
- Πρώτης τάξης (RC);
- Αποφυγή χρήσης R σε διατάξεις ισχύος ⇒ Απώλειες.
- Δεύτερης τάξης (LC)
 - Βαθυπερατό. Απόκριση συχνότητας;

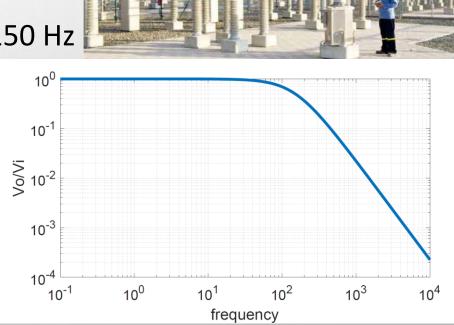


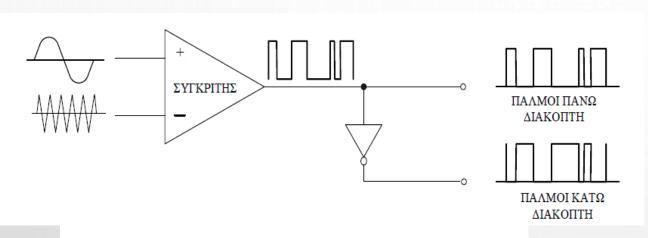
• Συχνότητα αποκοπής 150 Hz

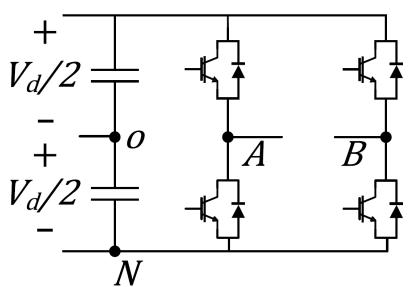


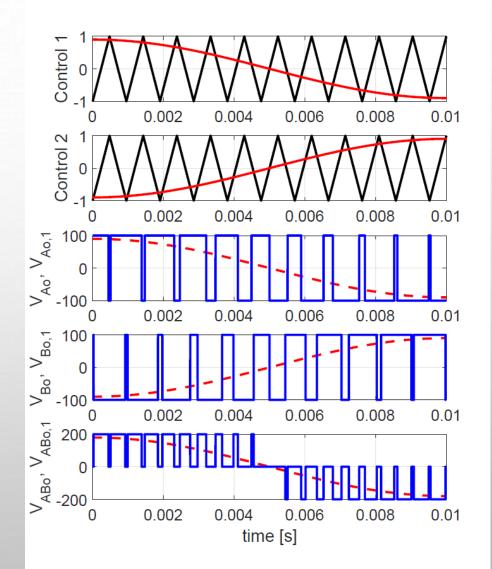






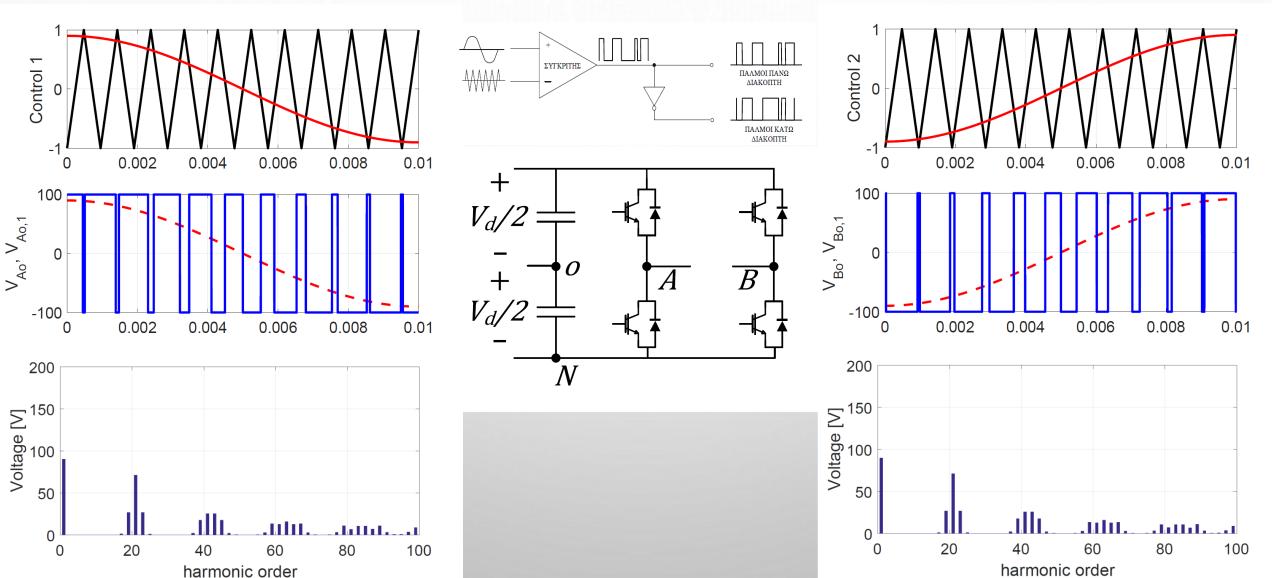


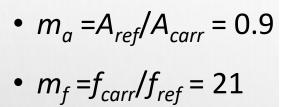




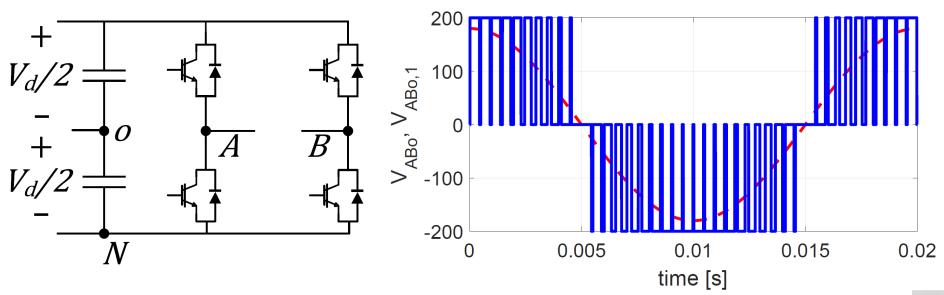
COV. METSOR. COV.

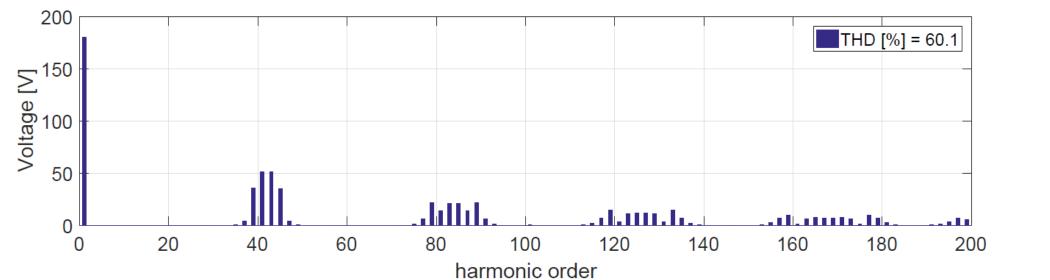
Βιομηχανική Ηλεκτρονική



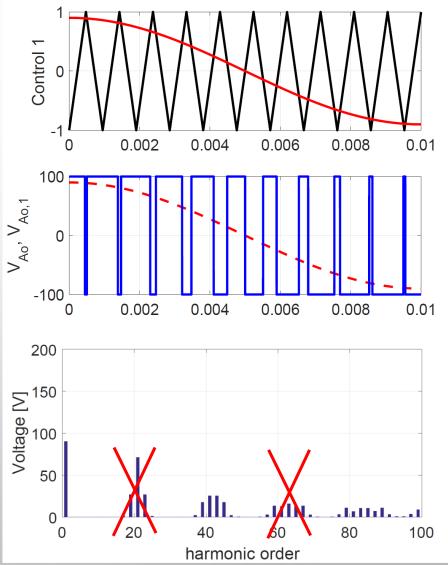


•
$$m_f = f_{carr}/f_{ref} = 21$$



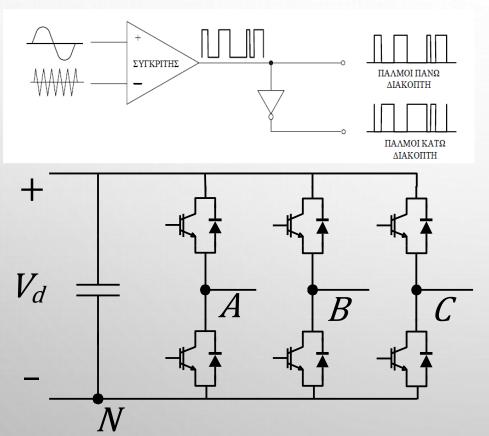


- Ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ θεμελιώδους και αρμονικών στο φάσμα εξόδου.
- Επιλογή διακοπτικής συχνότητας (ανά σκέλος):
 - m_f : περιττό, ακέραιο \Rightarrow Περιττές αρμονικές.
 - Περιττά πολλαπλάσια f_{carr} και άρτιες πλευρικές σε αυτά.
 - Γύρω από τα άρτια πολλαπλάσια της f_{carr} , μόνο οι περιττές πλευρικές σε αυτά.
- Μονοφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας ⇒
 - Εμφάνιση αρμονικών γύρω από τη συχνότητα $2m_f$.
 - Πλάτος τάσης εξόδου: $\widehat{V}_{AB,1}=m_aV_d$

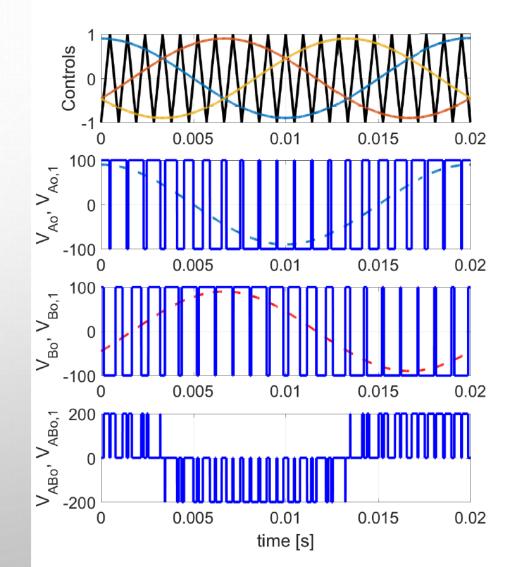


Τεχνική (ημιτονοειδούς) διαμόρφωσης εύρους παλμών (S)PWM -

Τριφασικός αντιστροφέας



• Πλάτος (πολικής) τάσης εξόδου: $\hat{V}_{AB,1} = m_a \sqrt{3} \frac{V_a}{2}$

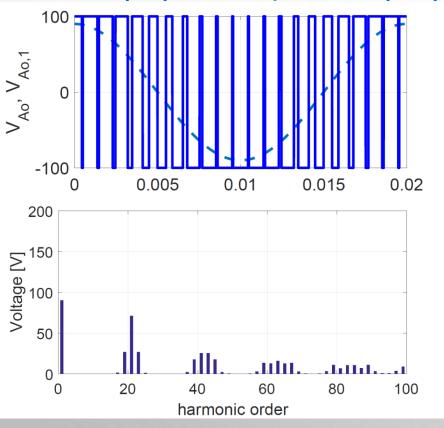


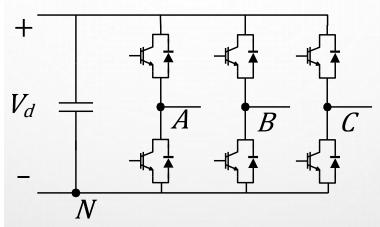
SO PONT OF THE STATE OF THE STA

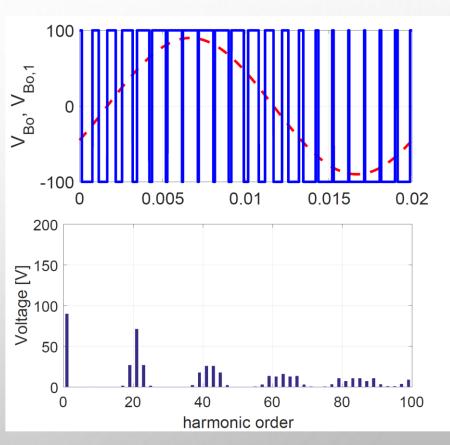
Βιομηχανική Ηλεκτρονική

Τεχνική (ημιτονοειδούς) διαμόρφωσης εύρους παλμών (S)PWM –

Τριφασικός αντιστροφέας





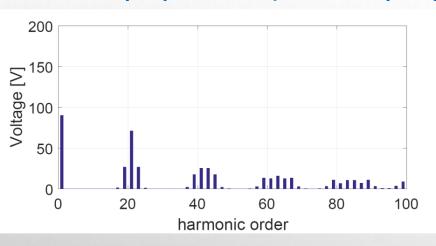


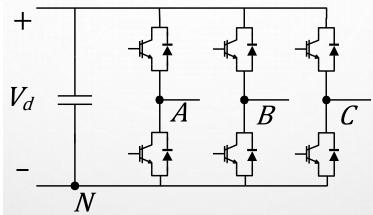
TOWN BENDER OF THE PROPERTY OF

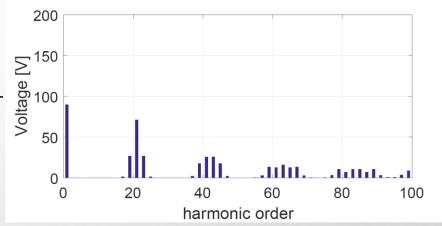
Βιομηχανική Ηλεκτρονική

Τεχνική (ημιτονοειδούς) διαμόρφωσης εύρους παλμών (S)PWM -

Τριφασικός αντιστροφέας

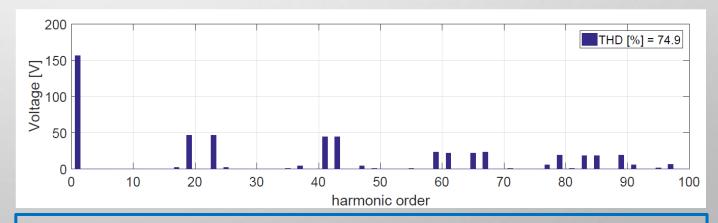






Εξάλειψη:

- Άρτιας τάξης
- Φέροντος και πολλαπλάσιων αυτού: $n \times m_f$
- $n \times m_f \pm 3$, 6, ... (τρίτες γύρω από κάθε πολλαπλάσιο του φέροντος)

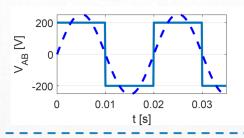


Εμφάνιση αρμονικών γύρω από τη συχνότητα φέροντος

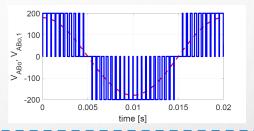


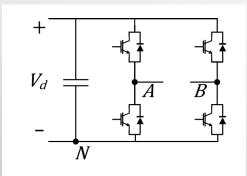
Αντιστροφείς ισχύος: Τάση εξόδου

• Τετραγωνικού παλμού



 Ημιτονοειδής διαμόρφωση εύρους παλμών





$$V_{AB,1}^{RMS} = \frac{4V_d}{\pi\sqrt{2}}$$

$$V_{AB,1}^{RMS} = m_a \frac{V_d}{\sqrt{2}}$$

$$V_d$$

$$V_{AB,1}^{RMS} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \frac{4}{\pi} \frac{V_{d}}{2}$$

$$V_{AB,1}^{RMS} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} m_a \frac{V_d}{2}$$